

**PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA**

**N.º 3709**

*Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.*

*Consultas de los clientes*

Semiconductor & Device Marketing Dept. A and Dept. B  
Mitsubishi Electric Corporation

[www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/](http://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/)

*Consultas de los medios*

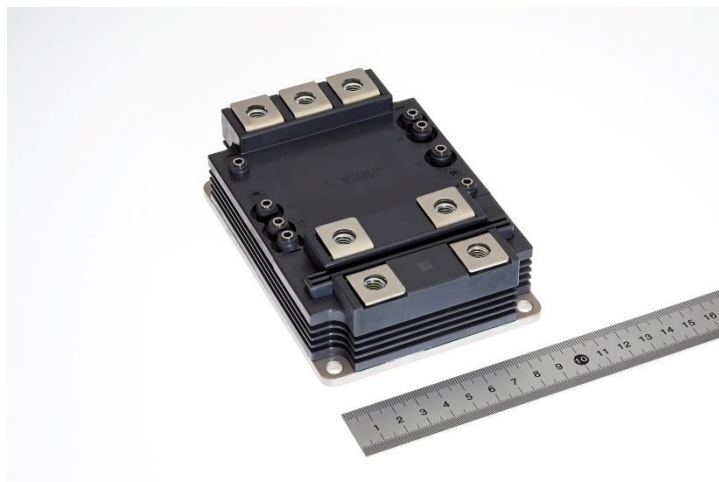
Public Relations Division  
Mitsubishi Electric Corporation

[prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp](mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp)

[www.MitsubishiElectric.com/news/](http://www.MitsubishiElectric.com/news/)

## **Mitsubishi Electric comercializa dos nuevos módulos MOSFET SiC integrados con SBD**

*Para una mayor potencia y eficiencia de los sistemas de inversores en sistemas de energía eléctrica, ferroviarios y muchos más*



Módulo MOSFET SiC integrado con SBD de 3,3 kV Unifull™

**TOKIO, 10 de junio de 2024** – [Mitsubishi Electric Corporation](https://www.mitsubishi-electric.com) (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha comenzado a comercializar versiones de 3,3k V/400 A y 3,3 kV/200 A de baja corriente de un módulo de transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET) de carburo de silicio (SiC) integrado con un diodo de barrera Schottky (SBD) para grandes equipos industriales, así como para material rodante y sistemas de energía eléctrica, a partir de hoy, día 10 de junio. Junto con la versión existente de 3,3 kV/800 A, la nueva serie Unifull™ consta de tres módulos para satisfacer la creciente demanda de inversores capaces de aumentar la salida de potencia y la eficiencia de conversión de potencia en grandes equipos industriales. Los nuevos módulos se mostrarán en las principales ferias comerciales, incluida la Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2024 en Nuremberg (Alemania), del 11 al 13 de junio.

Los módulos MOSFET SiC integrados con SBD de Mitsubishi Electric, incluida la versión de 3,3 kV/800 A lanzada el 29 de marzo, cuentan con una estructura de encapsulado optimizada para reducir la pérdida de conmutación y mejorar el rendimiento del SiC. En comparación con los módulos de potencia existentes, los módulos Unifull™ reducen considerablemente la pérdida de conmutación y contribuyen a una mayor potencia de salida y eficiencia en grandes equipos industriales, convirtiéndose así en una solución ideal para fuentes de alimentación auxiliares en sistemas ferroviarios y de propulsión con capacidades relativamente pequeñas.

### **Características del producto**

#### **1) Módulos de baja corriente adecuados para inversores de varias capacidades de salida**

- Las nuevas versiones de 3,3 kV/400 A y 3,3 kV/200 A del módulo MOSFET SiC integrado con SBD de Mitsubishi Electric, junto con las versiones de 3,3 kV/800 A ya existentes, conforman la nueva serie Unifull™.
- Los nuevos módulos de baja corriente son adecuados para fuentes de alimentación auxiliares de material rodante y sistemas de propulsión con una capacidad relativamente pequeña, lo que amplía la variedad de aplicaciones para mejorar la eficiencia de conversión de potencia de los inversores en grandes equipos industriales con requisitos de potencia variables.

#### **2) Los MOSFET SiC integrados con SBD mejoran la salida, la eficiencia y la fiabilidad de los inversores**

- Los MOSFET SiC integrados con SBD cuentan con una estructura de encapsulado optimizada que reduce la pérdida de conmutación en un 54 % en comparación con el módulo de potencia Full-SiC\* existente de Mitsubishi Electric y en un 91 % en comparación con el módulo de potencia Si\*\* existente de la empresa, lo que contribuye a una mayor potencia y eficiencia.
- La adopción de la estructura celular de activación de modelo bipolar (BMA) mejora la resistencia frente a sobretensiones y contribuye a mejorar la fiabilidad del inversor.

### **Especificaciones principales**

Modelo	FMF400DC-66BEW	FMF200DC-66BE
Tensión nominal	3,3 kV	3,3 kV
Corriente nominal	400 A	200 A
Tensión de aislamiento	6,0 kVrms	6,0 kVrms
Conexión	2 en 1	2 en 1
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	100 × 140 × 40 mm	100 × 140 × 40 mm
Fecha de comercialización	10 de junio de 2024	10 de junio de 2024

\* Comparaciones del nuevo módulo de 3,3 kV/400 A (FMF400DC-66BEW) con el módulo de potencia Full-SiC existente (FMF375DC-66A) y del nuevo módulo de 3,3 kV/200 A (FMF200DC-66BE) con el módulo de potencia Full-SiC (FMF185DC-66A)

\*\* Comparación del nuevo módulo de 3,3 kV/400 A (FMF400DC-66BEW) con el módulo de potencia Si (CM450DA-66X)

### **Gama de módulos MOSFET SiC integrados con SBD Unifull™**

Modelo	FMF800DC-66BEW	FMF400DC-66BEW	FMF200DC-66BE
Tensión nominal	3,3 kV	3,3 kV	3,3 kV
Corriente nominal	800 A	400 A	200 A
Tensión de aislamiento	6,0 kVrms	6,0 kVrms	6,0 kVrms
Fecha de comercialización	29 de marzo de 2024	10 de junio de 2024	10 de junio de 2024

Para contribuir a la descarbonización, se necesitan semiconductores de potencia que puedan convertir la potencia de forma eficiente, especialmente semiconductores de potencia SiC que sean capaces de reducir considerablemente la pérdida de potencia. Los módulos semiconductores de potencia para grandes equipos industriales se utilizan en equipos de conversión de potencia, como inversores para sistemas de tracción y fuentes de alimentación, transmisión de potencia de CC y mucho más. La demanda de módulos SiC de alta potencia y alta eficiencia es especialmente elevada, ya que pueden mejorar aún más la eficiencia de conversión de potencia y son compatibles con inversores con capacidades de salida variables.

#### **Sitio web**

[www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/](http://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/powerdevices/)

*Unifull es una marca registrada de Mitsubishi Electric Corporation.*

###

#### **Acerca de Mitsubishi Electric Corporation**

Con más de 100 años de experiencia en el suministro de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos de consumo, en la tecnología industrial, en la energía, en el transporte y en los equipos de construcción. A través del espíritu "Changes for the Better", Mitsubishi Electric se esfuerza por enriquecer la sociedad con tecnología. La empresa registró unos ingresos por valor de 5 257 000 millones de yenes (unos 34 800 millones de dólares estadounidenses\*) en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024. Si desea obtener más información, visite [www.MitsubishiElectric.com](http://www.MitsubishiElectric.com)

\* Las cantidades en dólares estadounidenses se han convertido a partir de yenes a un tipo de cambio de 151 yenes = 1 dólar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de marzo de 2024